

CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA Y ANATÓMICA DE RAÍCES DE PORTAINJERTOS DE SEMILLA Y CLONALES DE PALTO (*Persea americana* Mill).

C.Fassio¹, M. Castro¹, N. Darrouy¹ y J. Mamani¹.

¹Facultad de Agronomía. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. San Francisco s/n. La Palma Quillota. Chile. Correo electrónico: frutales@ucv.cl.

Las características morfológicas y anatómicas del sistema radical de portainjertos clonales y de semilla de palto (*Persea americana* Mill) fueron estudiadas a nivel de plantas de vivero. Para esta investigación fueron utilizados portainjertos de semilla sin injertar de 10 meses de desarrollo de las variedades Mexícola, Nabal, Reed y Zutano y portainjertos clonales de dieciocho meses, de las variedades Duke 7 y Toro Canyon. Las plantas fueron evaluadas en términos del diámetro de tronco, área, peso fresco y seco, a nivel foliar y radical. También fue evaluada la morfología del sistema radical identificando los tipos de raíces que componen el sistema (raíces finas con crecimiento primario y raíces gruesas con crecimiento secundario) y la secuencia con la que los distintos elementos se presentaron. Anatómicamente fueron determinados los distintos componentes observados a nivel histológico y fueron cuantificadas las proporciones del cilindro vascular y del cortex. Se pudieron determinar claras diferencias morfológicas entre el sistema radical adventicio presentado por los portainjertos clonales y el sistema radicular constituido por una raíz primaria y sus ramificaciones, presentado por los portainjertos de semilla. Histológicamente en ambos tipos de portainjertos raíces de diámetro menores a 2 mm presentaron un patrón de desarrollo distinto al de raíces de diámetros superiores, verificándose una clara especialización de las raíces de acuerdo a su diámetro y grado de lignificación. Las raíces finas y con mayor proporción de cortex estarían más relacionadas con la absorción, mientras que las más gruesas, con mayor proporción de estela estarían más relacionadas con el transporte.